

FIoT コンソーシアム 第2回総会・第4回研究会 プログラム

1. 【開催日時】：2024年2月16日(金) 13:00~17:00
2. 【開催方式】：会場と Microsoft Teams を使用したハイブリッド開催
3. 【開催会場】：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11階 第1会議室
4. 【会場アクセス】：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
5. 【プログラム】：

13:00~13:20 総会

13:20~13:30 (休憩 10分)

13:30~13:40 研究会 開会挨拶 FIoT コンソーシアム会長 植村 聖

13:40~14:40 講演1「2nm時代に向かう先端半導体パッケージ技術」
Rapidus 株式会社 3D アセンブリ本部 部長 野中 敏央 様
講演概要：2nm時代に向け、シリコンインターポーザーを用いた2.5D技術や有機基板上でのマルチチップパッケージ技術に加え、ファンアウトパッケージやブリッジチップ、そしてこれを組み合わせた技術がチップレット、ヘテロジニアスインテグレーションを推し進めようとしている。本講演では、これら技術について紹介する。

14:40~15:40 講演2「酸化ガリウムのパワーデバイス応用の現状」
株式会社ノベルクリスタルテクノロジー CTO 佐々木 公平 様
講演概要：カーボンニュートラルの実現に向けてパワーデバイスの更なる高効率化が求められている。酸化ガリウムはSiやSiCよりも絶縁破壊電界強度が大きく、次世代の低損失パワーデバイス用材料として期待されている。本講演では、酸化ガリウムパワーデバイス開発の最新動向を紹介する。

15:40~16:10 コーヒーブレイク

16:10~16:20 新入会員の皆さまの自己紹介

16:20~16:55 2023年度 分科会活動報告

16：55~17：00 閉会挨拶

FIoT コンソーシアム副会長 福田 伸子

【お問い合わせ先】：

FIoT コンソーシアム事務局（ <https://ssrc-fiot.jp> ）

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター内

E-mail：fiot-official-ml@aist.go.jp